

04;07

## Некоторые факторы, определяющие оптимальные характерные пробеги ускоренных лазерным излучением ионов в эквимолярном D–T-горючем

© М.Л. Шматов

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург  
E-mail: M.Shmatov@mail.ioffe.ru

В окончательной редакции 29 июня 2010 г.

Представлены модели, согласно которым на последних стадиях нагрева „горячего пятна“ в эквимолярном D–T-горючем протонами или другими ионами, ускоренными лазерным излучением, целесообразно использовать ионы с характерными пробегами, превышающими 1.2–1.5 г/см<sup>2</sup>.

В литературе широко обсуждается „быстрый поджиг“ термоядерных микровзрывов с нагревом „горячего пятна“ ионами, ускоренными лазерным излучением (см., например, [1–12]). Предполагалось, что для эквимолярного D–T-горючего оптимальный характерный пробег ионов  $R_{typ}$  в „горячем пятне“ находится в диапазоне 0.3–0.4 г/см<sup>2</sup> [2], 0.15–1.2 г/см<sup>2</sup> [3,5,8] или 1–1.5 г/см<sup>2</sup> [10]. Это предположение основано на том, что при фиксированном радиусе  $r_{hs}$  поперечно-однородного „горячего пятна“ цилиндрической формы такие  $R_{typ}$  соответствуют наименьшим достаточным значениям суммарной кинетической энергии  $E_{hs}$  ионов, попадающих в „горячее пятно“ [2–6,8,10,13,14]. Ограничение сверху на  $R_{typ}$  приводит к ограничениям сверху на характерную начальную кинетическую энергию иона  $\varepsilon_{typ}$  и тем самым на интенсивность  $I$  облучения источника ионов [3,5].

Использование микровзрывов для производства электроэнергии будет целесообразно только при приемлемой стоимости установки для их инициирования [6,15,16]. При нагреве „горячего пятна“ ионами, ускоренными лазерным излучением, это приводит к необходимости реализации сценариев с достаточно малой энергией  $E_{las}$  лазерного импульса, ускоряющего ионы [6,16]. По крайней мере, для некоторых

механизмов ускорения ионов лазерным излучением рост  $I$  вызывает рост эффективности ускорения  $\eta_{ac} = E_{ion}/E_{las}$ , где  $E_{ion}$  — суммарная кинетическая энергия ускоренных ионов [2,3,7]. Ниже представлены модели, согласно которым это, в сочетании с зависимостью наименьшего достаточного значения  $E_{hs}$  от  $r_{hs}$ , приводит к целесообразности выбора  $R_{typ} > 1.2-1.5 \text{ g/cm}^2$  на последних стадиях нагрева „горячего пятна“ в сжатом эквимолярном D–T-горючем. В некоторых случаях рост  $\eta_{ac}$  и  $\varepsilon_{typ}$  происходит и при росте длительности ускоряющего импульса [7]. Это может оказаться одной из дополнительных причин целесообразности выбора сравнительно больших  $R_{typ}$ .

Оценим пробег иона элемента с атомным номером  $Z$  в однородном „горячем пятне“ в эквимолярном D–T-горючем как

$$R[\text{g/cm}^2] \approx 5.15 \cdot 10^{-2} \frac{A(T_e[\text{keV}])^2}{Z_s^2} \int_{u_0}^{u_1} \frac{udu}{\Lambda G}, \quad (1)$$

где  $A$  — атомная масса иона,  $T_e$  — электронная температура „горячего пятна“,  $u_0 = 3m_e/m_i \approx 1.65 \cdot 10^{-3}/A$ ,  $m_e$  — масса электрона,  $m_i$  — масса иона,  $u_1 = m_e \varepsilon / (m_i T_e) \approx 0.549 \cdot \varepsilon [\text{MeV}] / (AT_e[\text{keV}])$ ,  $\varepsilon$  — кинетическая энергия иона на момент попадания в „горячее пятно“,

$$\Lambda \approx 6.08 - \ln \left\{ Z_s \sqrt{\rho[\text{g/cm}^3] [1 + 5.49 \cdot 10^{-4} \cdot Z_s / (Au)]} \right. \\ \left. \times (T_e[\text{keV}])^{-3/2} (1 + u)^{-1} \right\},$$

$\rho$  — плотность горючего в „горячем пятне“,  $G \approx \int_0^u dt \sqrt{t} \exp(-t) - 5.49 \cdot 10^{-4} \sqrt{u} \exp(-u)/A$  [3] (см. также [8]).

Для некоторых термоядерных мишеней  $\varepsilon$  может быть значительно меньше начальной кинетической энергии иона  $\varepsilon_1$  вследствие его торможения в сравнительно малоплотной плазме, окружающей основной ступок сжатого горючего [11]. Рассмотрим сначала ситуации, когда такое торможение несущественно, что может быть обеспечено, в частности, при размещении источника ионов в конусе (см. также [2,4,5]),  $E_{hs} \approx E_{ion}$  и  $R_{typ} \approx R(\varepsilon = \varepsilon_{typ})$ .

Обозначим интенсивность потока ускоренных лазерным излучением ионов вблизи их источника через  $I_{i0}$ . Для оценки зависимости  $I_{i0}$  и  $\varepsilon_{typ}$

от  $I$  воспользуемся выражениями

$$I_{i0}[\text{W/cm}^2] \approx 1.7 \cdot 10^{16} \sqrt{Z\lambda[\mu\text{m}]/A} \cdot [I/(10^{18} \text{ W/cm}^2)]^{5/4} \quad (2)$$

и

$$\varepsilon_{\text{тип}}[\text{MeV}] \approx 0.5Z\lambda[\mu\text{m}] \sqrt{I/(10^{18} \text{ W/cm}^2)}, \quad (3)$$

где  $\lambda$  — длина волны ускоряющего излучения [3]. Мгновенное значение  $\eta_{ac}$  равно  $I_{i0}/I$  [3].

Начнем с рассмотрения ситуации, когда разброс  $\varepsilon$  мал, вследствие чего пробеги всех ионов приблизительно равны, все значения  $R_{\text{тип}}$  не менее  $0.3 \text{ g/cm}^2$ , „горячее пятно“ — поперечно-однородный цилиндр, время его бомбардировки равно оптимальному значению  $t_{\text{опт}} = (54 \text{ ps}) \cdot [\rho/(100 \text{ g/cm}^3)]^{-0.85}$  (см. [6,13,14]),  $r_{hs}$  за это время не изменяется.

При  $0.3 \text{ g/cm}^2 \leq R_{\text{тип}} \leq R_0 = 1.2 \text{ g/cm}^2$  интенсивность бомбардировки поверхности „горячего пятна“  $I_{\text{bomb}}$  должна удовлетворять условию  $I_{\text{bomb}} \geq I_{\text{bomb}}^{\min}$ , где  $I_{\text{bomb}}^{\min}$  — параметр, зависящий от  $\rho$  и  $r_{hs}$  [6,13,14].

Оценим требования к  $I_{\text{bomb}}$  при  $R_{\text{тип}} \geq R_0$  как

$$I_{\text{bomb}} \geq I_{\text{bomb}}^{\min} \varepsilon_{\text{тип}} / \varepsilon_{\text{eff}}, \quad (4)$$

где  $\varepsilon_{\text{eff}}$  — энергия, теряемая ионом в основной области „горячего пятна“ с поверхностной плотностью  $R_0$ . Это выражение является аналогом выражения, представленного в работе [14] для случая, когда потери энергии иона на единицу длины пути в „горячем пятне“ постоянны и соответственно  $(\varepsilon/\varepsilon_{\text{eff}})(R \geq R_0) = R/R_0$ . При нахождении  $\varepsilon_{\text{eff}}$  можно использовать тот факт, что кинетическая энергия иона на выходе из основной области „горячего пятна“  $\varepsilon_{\text{тип}} - \varepsilon_{\text{eff}}$  соответствует пробегу  $R_{\text{тип}} - R_0$ .

Из (4) следует, что наименьшие необходимые значения  $E_{\text{las}}$  соответствуют наибольшим значениям параметра  $\eta = \eta_{ac}\eta_e$ , где  $\eta_e = \varepsilon_{\text{eff}}/\varepsilon_{\text{тип}}$ .

Рассмотрим в качестве примера нагрев „горячего пятна“ в течение малого промежутка времени  $t_1 \leq t \leq t_1 + \Delta t$  в ситуации, когда применимы выражения (1)–(4) и

$$I_{\text{bomb}}(t = t_1) \approx I_{i0}(t = t_1 - t_f) S_s(t = t_1 - t_f) / S_{hs}, \quad (5)$$

где  $t_f$  — время пролета от их источника до „горячего пятна“,  $S_s$  — площадь облучаемой области источника ионов,  $S_{hs}$  — площадь торца „горячего пятна“, что соответствует малому разбросу

**Таблица 1.** Некоторые параметры, характеризующие нагрев „горячего пятна“ с  $\rho = 300 \text{ g/cm}^3$  в эквимолярном D–T-горючем протонами при  $\lambda = 1 \mu\text{m}$

$T_e$ , keV	$R_{\text{ryp}}$ , g/cm <sup>2</sup>	$\varepsilon_{\text{ryp}}$ , MeV	$\varepsilon_{\text{eff}}$ , MeV	$I \cdot 10^{-19}$ , W/cm <sup>2</sup>	$\eta_{ac}$ , %	$\eta$ , %	$\eta I \cdot 10^{-18}$ , W/cm <sup>2</sup>
5	1.2	16.0	16.0	102	9.61	9.61	98.2
	1.5	20.7	18.9	171	10.9	9.99	170
	2	27.6	18.4	305	12.6	8.39	256
	2.5	33.7	16.1	455	14.0	6.68	304
10	1.2	4.81	4.81	9.25	5.27	5.27	4.88
	1.5	7.12	6.72	20.3	6.42	6.05	12.3
	2	11.5	9.23	53.3	8.17	6.53	34.8
	2.5	16.4	10.8	107	9.72	6.43	68.7

$\varepsilon$  и/или малому расстоянию между источником ионов и „горячим пятном“ (см. также [1–6,10–12]). Обозначим энергию лазерного импульса, затрачиваемую на ускорение ионов в течение рассматриваемого промежутка времени, через  $\Delta E_{\text{las}}$ . Из (4), (5) следует, что  $\Delta E_{\text{las}} \geq I_{\text{bomb}}^{\text{min}} S_{\text{hs}} \Delta t / \eta (t = t_1 - t_f)$ . Рост мгновенных значений  $\eta$  вызывает уменьшение нижних границ  $\Delta E_{\text{las}}$  и их суммы  $E_{\text{las}}$ .

В некоторых случаях могут возникнуть технические трудности, связанные с необходимостью попадания в „горячее пятно“ достаточно большого количества ионов  $N_{\text{ion}}$  (см., например, [11]). Наименьшие значения  $N_{\text{ion}}$  соответствуют наибольшим значениям  $\varepsilon_{\text{eff}}$ .

Из (1)–(3) следует, что рост  $R_{\text{ryp}}$  в диапазоне  $0.3\text{--}1.2 \text{ g/cm}^2$  сопровождается ростом  $\eta$ ,  $I_{i0}$  и  $\varepsilon_{\text{eff}}$  (при этом  $\eta = \eta_{ac}$ ,  $\varepsilon_{\text{eff}} = \varepsilon_{\text{ryp}}$ ; см. также [3,5]). Высокие значения  $I_{i0}$  при  $R_{\text{ryp}} \leq R_0$  и в общем случае  $I_{i0}\eta_e = \eta I$  желательны по нескольким причинам. Например, из (4) и (5) видно, что они либо облегчают фокусировку ионов на „горячее пятно“, либо вообще устраняют необходимость в ней. Реализация сценариев с  $R_{\text{ryp}} < R_0$  будет оправдана главным образом в ситуациях, когда используются ионы элементов со сравнительно большими  $Z$  и большие значения  $R_{\text{ryp}}$  недостижимы вследствие ограниченности  $I$  (см. (1), (3) и [3,5,8]).

В табл. 1 представлены примеры, соответствующие нагреву эквимолярного D–T-горючего с  $\rho = 300 \text{ g/cm}^3$  при  $\lambda = 1 \mu\text{m}$ ,  $T_e = 5$

и 10 keV протонами. „Горячее пятно“ должно быть нагрето до  $T_e \approx 12$  keV [6,13,14].

Данные из табл. 1 показывают, что для поздних стадий нагрева „горячего пятна“ протонами оправдан выбор  $R_{typ}$ , заметно, например приблизительно в два раза, превышающих  $R_0$ . Например, при  $T_e = 10$  keV рост  $R_{typ}$  от 1.2 до 2.5 g/cm<sup>2</sup> сопровождается ростом  $\eta$ ,  $\eta I$  и  $\varepsilon_{eff}$  приблизительно в 1.22, 14.1 и 2.25 раз соответственно. При  $T_e$  в несколько keV максимальные значения  $\eta$  могут соответствовать небольшому превышению  $R_{typ}$  над  $R_0$  (см. параметры, приведенные в табл. 1 для  $T_e = 5$  keV).

Данные из табл. 1 соответствуют росту  $\eta I$  при росте  $R_{typ}$  и немоной зависимости  $\eta(R_{typ})$ . В некоторых случаях на последних стадиях нагрева „горячего пятна“ оптимальные значения  $R_{typ}$ , соответствующие минимуму  $E_{las}$ , могут превышать величины, соответствующие максимумам  $\eta$ . Это связано с зависимостью наименьшего достаточного значения  $E_{hs}$  от  $r_{hs}$  и снижением требований к фокусировке ионов или исчезновении необходимости в ней при росте  $\eta I$ . Так, например, уменьшение  $r_{hs}$  от  $(2-3)r_{hs}^{opt}$ , где  $r_{hs}^{opt} = (60 \mu\text{m})[\rho/(100 \text{ g/cm}^3)]^{-0.97}$  — оптимальное значение  $r_{hs}$ , до  $r_{hs}^{opt}$  приведет к уменьшению наименьшего достаточного значения  $E_{hs}$  в 2–3.6 раза [6,14]. Отметим, что при  $\rho = 300 \text{ g/cm}^3$  и  $r_{hs} = r_{hs}^{opt} \approx 21 \mu\text{m}$   $I_{bomb}^{min} \approx 6.82 \cdot 10^{19} \text{ W/cm}^2$  [6,13,14], что меньше  $\eta I$  ( $T_e = 10$  keV,  $R_{typ} = 2.5 \text{ g/cm}^2$ ) и больше остальных значений  $\eta I$  ( $T_e = 10$  keV) из табл. 1.

Рост  $\eta$  при росте  $R$  ( $\varepsilon = \varepsilon_{typ}$ ) в некотором диапазоне возможен и при значительном разбросе значений  $\varepsilon$ . Рассмотрим в качестве примера ситуации, когда  $\rho = 300 \text{ g/cm}^2$ ,  $T_e = 10$  keV,  $\lambda = 1 \mu\text{m}$ , „горячее пятно“ нагревается протонами, плотность их распределения по энергиям постоянна в интервале  $0.5\varepsilon_{typ} - 1.5\varepsilon_{typ}$  или  $0.75\varepsilon_{typ} - 1.25\varepsilon_{typ}$  и равна нулю вне его,  $t_f$  мало. Обозначим средние значения  $\varepsilon_{eff}$  для этих распределений через  $\langle \varepsilon_{eff1} \rangle$  и  $\langle \varepsilon_{eff2} \rangle$  соответственно. Можно показать, что при  $R(\varepsilon = \varepsilon_{typ}) = R_0$   $\langle \varepsilon_{eff1} \rangle \approx 0.981\varepsilon_{typ} \approx 4.72 \text{ MeV}$ ,  $\langle \varepsilon_{eff2} \rangle \approx 0.992\varepsilon_{typ} \approx 4.77 \text{ MeV}$ , а при  $R(\varepsilon = \varepsilon_{typ}) = 2.5 \text{ g/cm}^2$   $\langle \varepsilon_{eff1} \rangle \approx 0.637\varepsilon_{typ} \approx 10.4 \text{ MeV}$ ,  $\langle \varepsilon_{eff2} \rangle \approx 0.655\varepsilon_{typ} \approx 10.7 \text{ MeV}$ . Это соответствует тому, что рост  $R(\varepsilon = \varepsilon_{typ})$  от 1.2 до 2.5 g/cm<sup>2</sup> сопровождается ростом  $\eta$  приблизительно в 1.20 раза (от  $5.17 \cdot 10^{-2}$  до  $6.19 \cdot 10^{-2}$ ) при первом распределении протонов по энергиям и приблизительно в 1.22 раза (от  $5.23 \cdot 10^{-2}$  до  $6.37 \cdot 10^{-2}$ ) при втором (см. значения  $\eta_{ac}$  в табл. 1).

**Таблица 2.** Некоторые параметры, характеризующие нагрев „горячего пятна“ с  $\rho = 300 \text{ g/cm}^3$  в эквиволярном D–T-горючем при  $T_e = 10 \text{ keV}$  и  $\lambda = 1 \mu\text{m}$  протонами, проходящими через слой плазмы с плотностью  $50 \text{ g/cm}^3$ , толщиной  $100 \mu\text{m}$  и электронной температурой  $10 \text{ keV}$

$R_{typ}, \text{g/cm}^2$	$\varepsilon_{typ}, \text{MeV}$	$\varepsilon_{eff}, \text{MeV}$	$I \cdot 10^{-20}, \text{W/cm}^2$	$\eta_{ac}, \%$	$\eta, \%$	$\eta I \cdot 10^{-19}, \text{W/cm}^2$
1.2	9.39	4.81	3.52	7.37	3.77	1.33
1.5	12.1	6.72	5.59	8.37	4.64	2.73
2	17.0	9.23	11.5	9.90	5.39	6.20
2.5	21.9	10.8	19.2	11.2	5.55	10.6

По крайней мере, в некоторых случаях выбор  $R_{typ} > R_0$  на последних стадиях нагрева „горячего пятна“ в эквиволярном D–T-горючем будет целесообразен и при существенном торможении ионов в малоплотной плазме. В табл. 2 представлен пример для случая, когда перед попаданием в „горячее пятно“ с  $\rho = 300 \text{ g/cm}^3$ ,  $T_e = 10 \text{ keV}$  протоны проходят через слой плазмы с плотностью  $50 \text{ g/cm}^3$ , толщиной  $100 \mu\text{m}$  и такой же электронной температурой,  $\lambda = 1 \mu\text{m}$ . Полагается, что все значения  $\varepsilon_1$  приблизительно равны  $\varepsilon_{typ}$ . Рост  $R_{typ}$  от 1.2 до  $2.5 \text{ g/cm}^2$  сопровождается ростом  $\eta$ ,  $\eta I$  и  $\varepsilon_{eff}$  приблизительно в 1.47, 8.01 и 2.25 раз соответственно (см. табл. 2).

Выбор  $R_{typ} > R_0$  может быть целесообразен и при нагреве „горячего пятна“ ионами углерода и других элементов с  $Z > 1$  (см. [2–5,8,11,12]). Так, например, модель, основанная на уравнениях (1)–(3), дает, что при нагреве „горячего пятна“ ионами углерода в ситуации, когда торможение ионов в малоплотной плазме несущественно, а разброс  $\varepsilon_1$  пренебрежимо мал, при  $\rho = 300 \text{ g/cm}^2$  и  $T_e = 10 \text{ keV}$   $\eta(R_{typ} = R_0) \approx 0.101$ ,  $\eta(R_{typ} = 1.5 \text{ g/cm}^2) \approx 0.112$ ,  $\eta(R_{typ} = 2 \text{ g/cm}^2) \approx 0.106$ . Отметим, что модель ускорения ионов углерода, представленная в работе [12], в некоторых случаях соответствует более сильному росту  $\eta_{ac}$  при росте  $R_{typ}$ , чем модель, использующая уравнения (2), (3).

Проблема выбора  $R_{typ}$  при нагреве „горячего пятна“ дейтронами и тритонами, ускоряемыми в самом горючем (см., например, [10]), требует дополнительных исследований.

В заключение отметим, что достижение высоких значений  $\eta I$  и  $\varepsilon_{eff}$  за счет выбора  $R_{тип} > R_0$  может быть полезно и при снижении  $E_{las}$  с помощью профилирования „горячего пятна“ (см., например, [8,9,14]).

Автор благодарит В.Т. Тихончука за полезные дискуссии, рецензентов за полезные комментарии на первый вариант статьи и Международное агентство по атомной энергии за частичное финансирование исследований в области использования термоядерных микровзрывов для получения электроэнергии в рамках Исследовательского контракта МАГАТЭ № RUS 13722.

## Список литературы

- [1] Roth M., Cowan T.E., Key M.H. et al. // Phys. Rev. Lett. 2001. V. 86. P. 436–439.
- [2] Гуськов С.Ю. // Квантовая электроника. 2001. Т. 31. № 10. С. 885–890.
- [3] Быченко В.Ю., Розмус В., Максимчук А. и др. // Физика плазмы. 2001. Т. 27. С. 1076–1080.
- [4] Atzeni S., Temporal M., Honrubia J.J. // Nucl. Fusion. 2002. V. 42. P. L1–L4.
- [5] Shmatov M.L. // Fusion Sci. Technol. 2003. V. 43. P. 456–467.
- [6] Tabak M., Hinkel D., Atzeni S. et al. // Fusion Sci. Technol. 2006. V. 49. P. 254–277.
- [7] Borghesi M., Fuchs J., Bulanov S.V. et al. // Fusion Sci. Technol. 2006. V. 49. P. 412–439.
- [8] Shmatov M.L. // J. Phys.: Conf. Ser. 2008. V. 112. Pap. 022061.
- [9] Temporal M., Ramis R., Honrubia J.J., Atzeni S. // Plasma Phys. Control. Fusion. 2009. V. 51. Pap. 035010.
- [10] Naumova N., Schlegel T., Tikhonchuk V.T. et al. // Phys. Rev. Lett. 2009. V. 102. Pap. 025002.
- [11] Honrubia J.J., Fernández J.C., Temporal M. et al. // Phys. Plasmas. 2009. V. 16. Pap. 102701.
- [12] Benedetti C., Londrillo P., Liseykina T.V. et al. // NIM A. 2009. V. 606. P. 89–93.
- [13] Atzeni S. // Phys. Plasmas. 1999. V. 6. P. 3316–3326.
- [14] Atzeni S., Tabak M. // Plasma Phys. Control. Fusion. 2005. V. 47. P. B769–B776.
- [15] Teller E. // IEEE Spectrum. 1973. V. 10. N 1. P. 60–63.
- [16] Meier W.R., Hogan W.J. // Fusion Sci. Technol. 2006. V. 49. P. 532–541 (corrigenda: 2007. V. 52. P. 118).